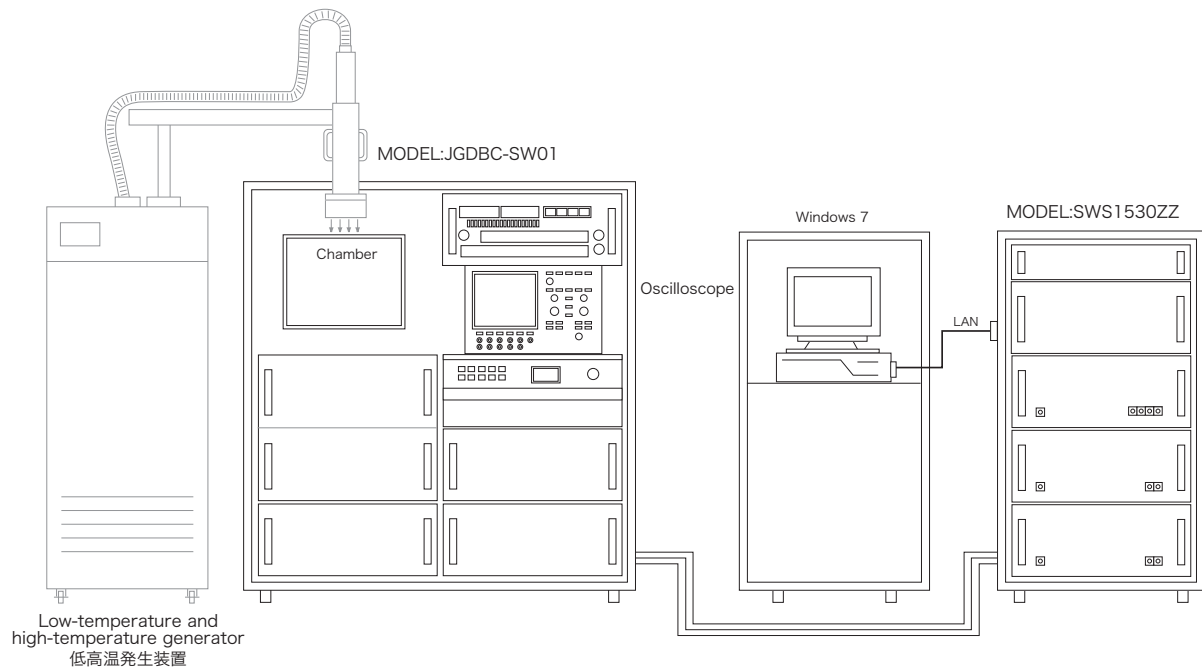


# SWITCHING TIME TEST SYSTEM / スイッチングタイムテストシステム

## MODEL:SWS1530ZZ

SWS1530ZZ has been designed to test short circuit tolerance and switching characteristics of IGBT, MOS-FET and DIODE. It is possible to test automatically with temperature environment of  $-40^{\circ}\text{C}$ ~ $175^{\circ}\text{C}$ , and from low breakdown voltage to high breakdown voltage area.

本器は、IGBT、MOS-FET、ダイオードのスイッチング特性、及び短絡耐量を測定する装置です。低耐圧より高耐圧領域、また、温度環境 $-40^{\circ}\text{C}$ ~ $175^{\circ}\text{C}$ まで自動で測定可能です。



### 【Specifications / 基本仕様】

#### 1) Measurement Items / 測定項目

①R-load Switching / R負荷スイッチング	1500V / 999A / 200 $\mu\text{s}$ (Max)
②L-load Switching / L負荷スイッチング	1500V / 999A / 200 $\mu\text{s}$ (Max)
③di/dt	1500V / 999A / 200 $\mu\text{s}$ (Max)
④AVALANCHE (Reverse bias ASO / 逆バイアスASO)	1500V / 999A / 200 $\mu\text{s}$ (Max)
⑤QG	1500V / 999A / 200 $\mu\text{s}$ (Max)
⑥Short Circuit ASO / 短絡ASO	1500V / 3000A / 100 $\mu\text{s}$ (Max)

#### 2) Measurement Conditions / 測定条件

VDD	0020V~1500V	1V STEP	4 digits / 4桁
ID (limit)	0001A~3000A	1A STEP	4 digits / 4桁
VGP(VGF/VGR) / VGN(VGF/VGR)	$\pm 00.0\text{V}$ ~ $\pm 30.0\text{V}$	0.1V STEP	3 digits / 3桁
IG	To choose from 0.1mA, 1mA and 10mA 0.1mA/1mA/10mAより選択		

#### 3) Breaking circuit when device is destroyed / デバイス破壊時の遮断回路

If device is destroyed, overcurrent and short-circuit will be detected.

However, current is cut by breaking circuit, and contact is protected, and device destruction is minimized.

デバイス破壊時、過電流、ショートを検出し、遮断回路により電流をカットしコンタクト保護対策としデバイス破壊を最小限とします。



半導体デバイス試験装置メーカー  
株式会社 キャッツ電子設計

#### CONTACT

■TEL : CATS Inc. SENDAI OFFICE TEL.022-371-8777  
■E-mail : cats-sendai@world.ocn.ne.jp

\* Reproduction or appropriation of writings, images and photographs from within this catalogue is prohibited.

\* 本カタログ内の記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。